

KT812A-KT812B

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ HIGH-POWER MEDIUM-FREQUENCY TRANSISTORS

Транзисторы KT812A-KT812B предназначены для работы в высоковольтных импульсных схемах, в выходных каскадах строчной развертки телевизоров и другой аппаратуры широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT812A-KT812B transistors are designed for use in high-voltage pulse circuits, in the output stages of TV horizontal sweep and other circuits in a wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -45...+85^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$U_{CBM\ max.}$ ($t_p \leq 20\ \mu s, Q \geq 3$), V:

KT812A	700
KT812Б	500
KT812В	300

$U_{CE\ max.}$, V:

KT812A	400
KT812Б	300
KT812В	200

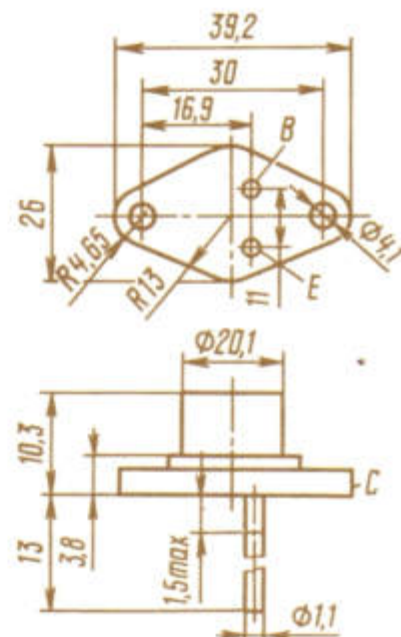
$U_{EB\ max.}$, V

7

$I_C\ max.$, A

8

38



$I_{CM\ max.}$ ($t_p \leq 1\ ms, Q \geq 10$,

$t_p \leq 50\ \mu s, Q \geq 2$), A

12

$I_B\ max.$, A

3

$I_{BM \max}$, ($t_p \leq 1 \text{ ms}$, $Q \geq 10$), A 4
 $t_p \leq 50 \mu\text{s}$, $Q \geq 2$, A 4
 $P_C \max$, ($t_{case} \leq 50^\circ\text{C}$), W 50
 $t_j \max$, $^\circ\text{C}$ 150

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	КТ812А	КТ812Б	КТ812В	Режимы Conditions
1	2	3	4	5
I_{CER}, mA	≤ 5	≤ 5	≤ 5	$U_{CE} = 700 \text{ V}$ $U_{CE} = 500 \text{ V}$ $U_{CE} = 300 \text{ V}$

$R_B =$
 $= 10 \Omega$

1	2	3	4	5
I_{EBO}, mA	≤ 150	≤ 150	≤ 150	$U_{EB} = 7 \text{ V}$
h_{21E}	≥ 4	≥ 4	—	$U_{CB} = 2,5 \text{ V}$ $I_C = 8 \text{ A}$
	—	—	≥ 10	$U_{CB} = 5 \text{ V}$ $I_C = 5 \text{ A}$
$t_f, \mu\text{s}$	$\leq 1,8$	$\leq 1,8$	$\leq 1,8$	$U_{CB} = 100 \text{ V}$ $I_C = 5 \text{ A}$ $I_{B1} = I_{B2} = 2,5 \text{ A}$
$U_{BE \text{ sat}}, \text{V}$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$I_C = 8 \text{ A}$ $I_B = 2 \text{ A}$

